2026 年度第３回半導体エレクトロニクス部門委員会第２回研究会
2026 年度第１回ナノ材料部門委員会第１回研究会

主催： 日本材料学会ナノ材料部門委員会
日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
期日： 2026 年 11 月 21 日（土） 13：00 ～ 16：15
会場： 京都大学桂キャンパス A2 棟 306 講義室
発表形式：招待講演 口頭講演 30 分（質疑応答込）
一般講演 口頭発表 20 分/件（質疑応答込）

13:00 オープニング 田中 勝久（ナノ材料部門委員会委員長、京都大）

座長：田中 勝久（京都大）

13:05 **招待講演「メタサーフェスによる高量子収率蛍光体からの指向性光取出し」**
村井 俊介（大阪公立大大学院工学研究科）

一般講演

13:35 ①**「マスクレス成長した三次元 GaN マイクロ構造の成長発展過程の解析」**
◇河本 陽平[1]，松田 祥伸[1]，船戸 充[1]
（1.京都大院工）

13:55 ②**「InGaN 系マイクロ LED による波長分割多重可視光通信のチャネル配置最適化」**
◇藤田 将成[1]，松田 祥伸[1]，船戸 充[1]
（1.京都大院工）

14:15 ③**「有機金属気相エピタキシャル法による AlGaN への Eu 添加と Eu 発光特性の評価」**
◇前田 琉晴[1]，小倉 毅勇[2]，井口 勝次[2]，荒木 努[1]，藤原 康文[2]
（1.立命館大院理工，2.立命館大総合科学技術研究機構）

休憩（14:35-14:50）

座長：荒木 務（立命館大）

14:50 ④**「4H-SiC 基板上への酸化ガリウム薄膜のミスト CVD 成長：単相 β 型酸化ガリウムの成長と面内結晶方位の評価」**
◇大宅 泰生[1]，宇野 和行[1]
（1.和歌山大システム工）

15:10 ⑤**「ミスト CVD 法による β-Fe_2O_3 バッファ層を用いた YSZ 基板上への δ-Ga_2O_3 薄膜成長と熱的安定性」**
◇齋藤 蒼生[1]，島添 和樹[2]，西中 浩之[1]
（1.京都工芸繊維大，2.名古屋工業大）

15:30 ⑥**「Nernst 限界を超える pH 感度を有する多孔質ナノシリカ膜の作製と拡張ゲート FET 型尿素センサーへの応用」**

◇本多 真也[1]，山名 一生[1]，橋本 恵夢[1]，広藤 裕一[1]，廣芝 伸哉[1]，小池 一歩[1]

（1.大阪工業大ナノ材研センター）

15:50 ⑦**「応力による非晶質 TiO_2ナノ粒子アレイシールの光学特性の動的制御」**

◇伊東 駿太[1]，村井 俊介[2]，田中 勝久[1]

（1. 京大院工，2. 大阪公立大院工）

16:10　クロージング　荒木 務（半導体エレクトロニクス部門委員会委員長、立命館大）

終了（16:15）

◇：「学生優秀講演賞」応募講演